

99-0205

Изобретение относится к фотонике, в частности к полупроводниковым фотоприемникам.

Фотоприемник выполнен на диэлектрической подложке, на которую последовательно нанесены первый полупрозрачный контактный электрод, фоточувствительный слой из стеклообразного халькогенидного полупроводника мышьяк - селен, допированный оловом, с формулой $(AsSe)_{100-x}:Sn_x$, где $7,5 \leq x \leq 10,0$ ат. % и второй полупрозрачный контактный электрод.